

GaAs 单片低噪声放大器(封装) 0.8GHz~1.6GHz NF 0.4dB

**Rev 1.**4

### 关键指标

▶ 频率范围: 0.8GHz~1.6GHz

▶ 增益: 30dB▶ 噪声系数: 0.4dB▶ 输出 P-1dB: 12dBm▶ 供电电源: +5V@50mA

▶ 封装尺寸: 3mm x3mm x0.75mm

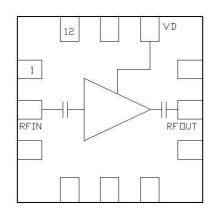
## 典型应用

- ▶ 卫星通信
- ▶ 军事及航天
- ➢ 测试测量仪器
- ▶ 雷达

### 产品简介

XT3063QP3 是无引线 3x3mm 表面贴装封装的 GaAs MMIC 低噪声放大器, 工作于 0.8GHz~1.6GHz,采用 GaAs 工艺制成。该放大器的增益为 30dB,输出 P-1dB 为 12dBm,在 +5V的电压下噪声系数为 0.4dB。

### 功能框图



### 电性能 (T<sub>A</sub>=25°C,V<sub>D</sub>=+5V,I<sub>D</sub>=50mA,Z<sub>0</sub>=50Ω)

指标	最小值	典型值	最大值	单位
频率		0.8~1.6	)	GHz
增益	25	30		dB
增益平坦度	_	±1.5		dB
反向隔离度	-35	-45	_	dB
输入/输出回波损耗	_	-13	-10	dB
噪声系数	_	0.4	0.65	dB
输出 P-1dB	11	12	_	dBm
输出 I P 3 *	_	24	_	dBm
工作电压	4.85	5	5.3	V
工作电流	_	50	_	mA

<sup>\*</sup>Pout / Tone = 0dBm, fc= 1GHz, $\Delta f=5MHz$ 

### 绝对最大额定值

最大输入功率	+12dBm	工作温度	-55℃~+85℃
沟道温度	+150℃	贮存温度	-65℃~+150℃
最大VD	+5.5V		

### ※ 成都仙童科技有限公司

1

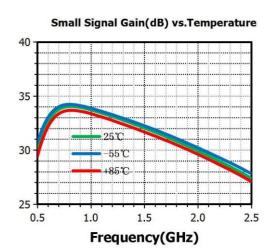


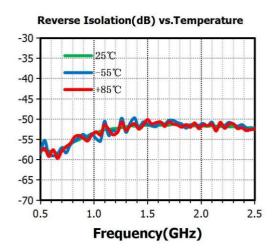
GaAs 单片低噪声放大器(封装) 0.8GHz~1.6GHz NF 0.4dB

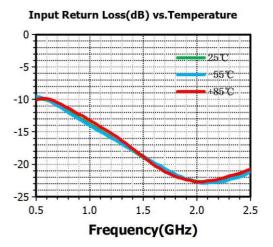
**Rev 1.3** 

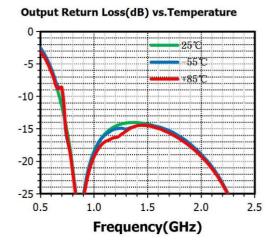
### 典型测试曲线

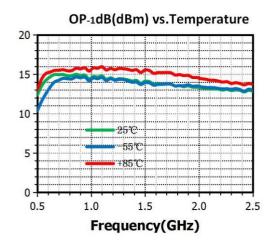
测试数据为夹具测试结果

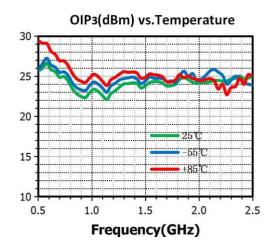








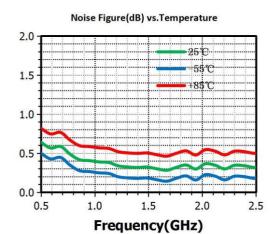




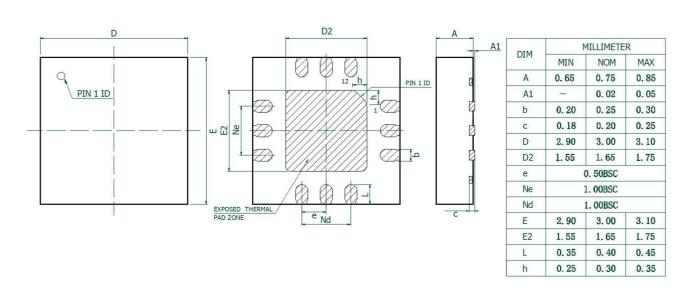


GaAs 单片低噪声放大器(封装) 0.8GHz~1.6GHz NF 0.4dB

**Rev 1.3** 



### 外形尺寸图(mm)



### 引脚定义

编号	定义	编号	定义	
1	接地	10	漏极供电	
2	射频输入	11	接地	
3	接地	12	接地	
4	接地			
5	接地			
6	接地			
7	接地			
8	射频输出			
9	接地			

### ※ 成都仙童科技有限公司



GaAs 单片低噪声放大器(封装) 0.8GHz~1.6GHz NF 0.4dB

Rev 1.3

# **应用电路图**C2 C2 C1 C1 C1 C1 A 5 6 7

### 元件清单

编号	数值	型号	制造商	尺寸
C1	0.01µF	GRM15R71H103K	村田	0402
C2	4700pF	GRM1555C1H472J	村田	0402

### 注意事项:

- 1、产品防潮等级为 2a 级,存放环境小于或等于 30° C/60% RH,四周车间寿命;
- 2、撤除真空包装,上回流焊前需在 125+/-5° 环境中烘焙 6 小时,方可焊接。